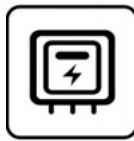


自主封測 品質把控 售後保障

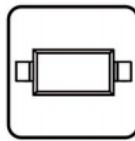
WEB WWW.TDSEMIC.COM 



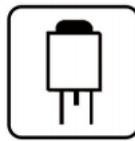
電源管理



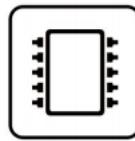
顯示驅動



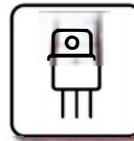
二三極管



LDO穩壓器



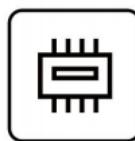
觸摸芯片



MOS管



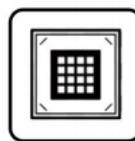
運算放大器



存儲芯片



MCU



串口通信

CA3140N-TD

產品規格說明書-

MOS 输入单运算放大器

概述

CA3140-TD是单路集成运算放大电路，它在一块单片上结合了高压 PMOS 和高压双极型晶体管的优点。CA3140-TD在输入电路中加入了带有栅极保护的 MOSFET(PMOS)，从而提供了非常高的输入阻抗，极低的输入电流以及高速的性能。

CA3140-TD采用 SOP8 和 DIP8 封装形式。

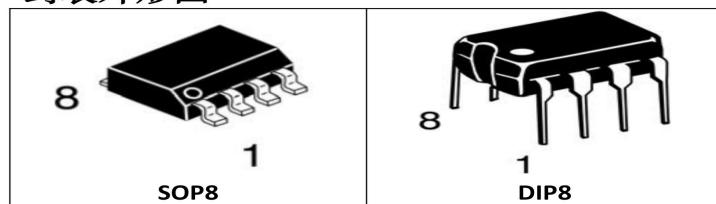
主要特点

- 低功耗: 4mA
- 宽共模输入电压范围
- 宽差模输入电压范围
- 低输入偏置电流: 50 pA
- 低输入失调电流: 30 pA
- 输出短路保护
- 高转换速率: 9V/uS
- 高增益带宽积: 4.5MHz

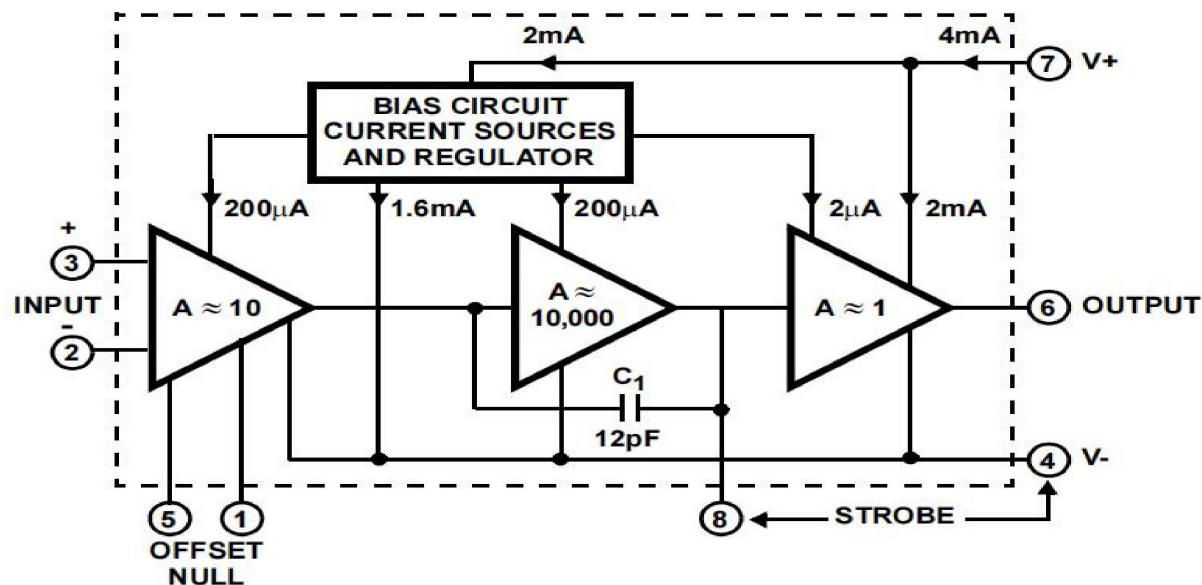
主要应用领域

- 峰值探测器
- 比较器
- 采样和保持放大器

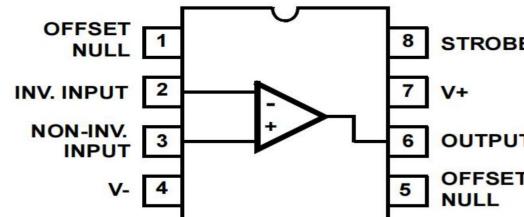
封装外形图



功能框图



管脚说明

管脚序号	管脚名称	I/O	描述	管脚排列图
1	OFFSET NULL	I	偏置 (调零端)	
2	INV.INPUT	I	反向输入端	
3	NON-INV.INPUT	I	同向输入端	
4	V-	P	负电源	
5	OFFSET NULL	I	偏置 (调零端)	
6	OUTPUT	O	输出	
7	V+	P	正电源	
8	STROBE	I	选通端	

极限参数 (若无其它规定, Tamb=25°C)

参数	标识	值
电源电压	V _{CC}	±18V
差分输入电压	V _{ID}	±8V
输入端电流	I _{IN}	1 mA
最大工作结温	T _J	150°C
贮存温度	T _S	-65 ~ +150°C
铅温度 (焊接, 10s)	T _W	260°C

推荐工作条件 (若无其它规定, Tamb=25°C)

参数	符号	最小值	最大值	单位
正电源	V +	+5	+15	V
负电源	V -	-5	-15	V
共模输入电压	V _{CM}	(V -) + 4	(V +) - 4	V
工作温度范围	T _A	-20	+85	°C
工作结温	T _J	-20	+125	°C

电气特性 (若无其它规定, V+=15V, V-=15V, Tamb=25°C)

参数	标识	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入偏置电压调整电阻	/	调整到最大输入电压时 4&5 脚或 4&1 脚间电阻的典型值	-	4.7	-	kΩ
输入电阻	R _I		-	1	-	TΩ
输入电容	C _I		-	4	-	pF
输出电阻	R _O		-	60	-	Ω
等效宽带输入噪声电压	e _N	BW=140kHz, R _S =1MΩ	-	48	-	μV

等效输入噪声电压	e_N	$RS=100\Omega$	$f=1\text{kHz}$	-	40	-	nV/VHz
			$f=10\text{kHz}$	-	12	-	nV/VHz
短路电流相反于供电	I_{OM+}	-	Source	-	45	-	mA
	I_{OM-}		Sink	-	18	-	mA
增益带宽积	$GBWP$			-	4.5	-	MHz
转换速率	SR			-	9	-	$\text{V}/\mu\text{s}$
输出变为低电平时 8 端流入 4 端的灌电流	I_{SINK}			-	220	-	μA
动态响应	t_r	$R_L=2\text{k}\Omega$ $C_L=100\text{pF}$	上升时间	-	0.08	-	μs
	OS		过冲	-	10	-	%
在 $10\text{V}_{\text{P-P}}$ 的建立时间	t_s	$R_L=2\text{k}\Omega, C_L=100\text{pF}$ 电压跟随器	到 1mV	-	4.5	-	μs
			到 10mV	-	1.4	-	μs

电气特性 (若无其它规定, $V_+=15V$, $V_-=-15V$, $T_{amb}=25^{\circ}C$)

参数	标识	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入失调电压	V_{IO}		-	3	6	mV
输入失调电流	I_{IO}		-	3	6	mA
输入电流	I_I		-	-	30	pA
大信号电压增益	A_{OL}		70	90	-	dB
共模抑制比	CMRR		70	80	-	dB
电源抑制比	PSRR		76	80	-	dB
最大输出电压	V_{OM+}		12	12.8	-	V
	V_{OM-}		-14	-14.4	-	V
电源电流	I_+		2	5	6.5	mA
输入失调电压温漂	$\Delta V_{IO}/\Delta T$		-	10	-	uV/°C

典型应用

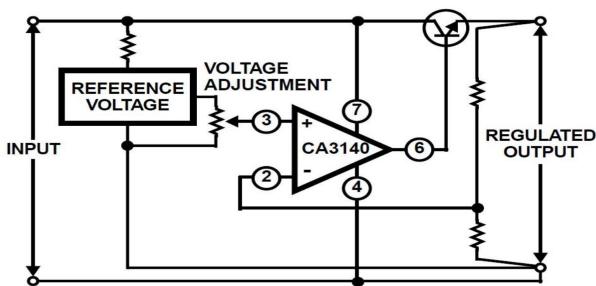


图 1 基本单电源电压调节器

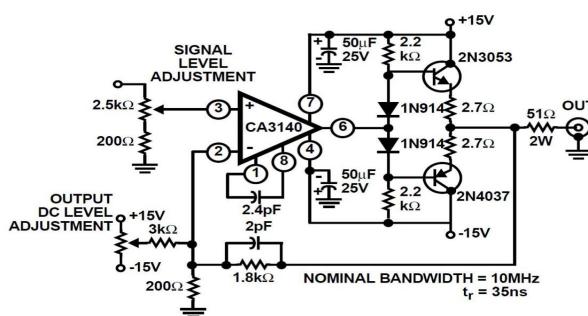


图 2 宽带输出放大器

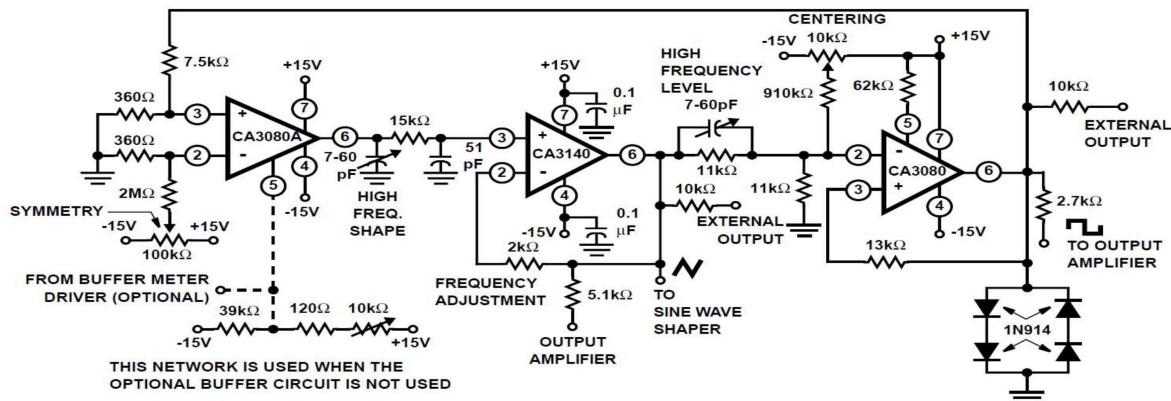


图 3 超级扫描函数发生器

特性曲线

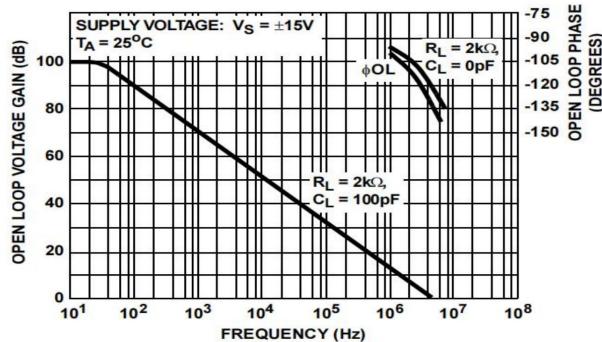


图 4 开环电压增益和相位与频率关系

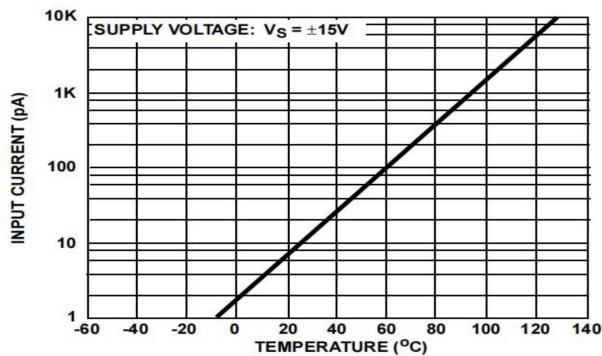


图 5 输入电流与环境温度关系

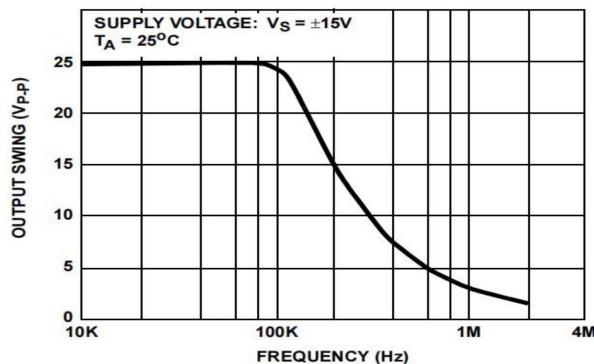


图 6 最大输出电压摆幅与频率关系

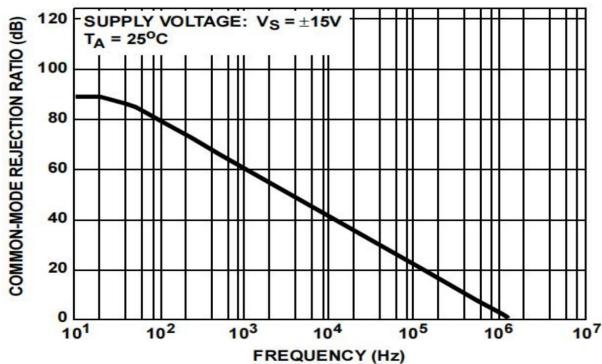
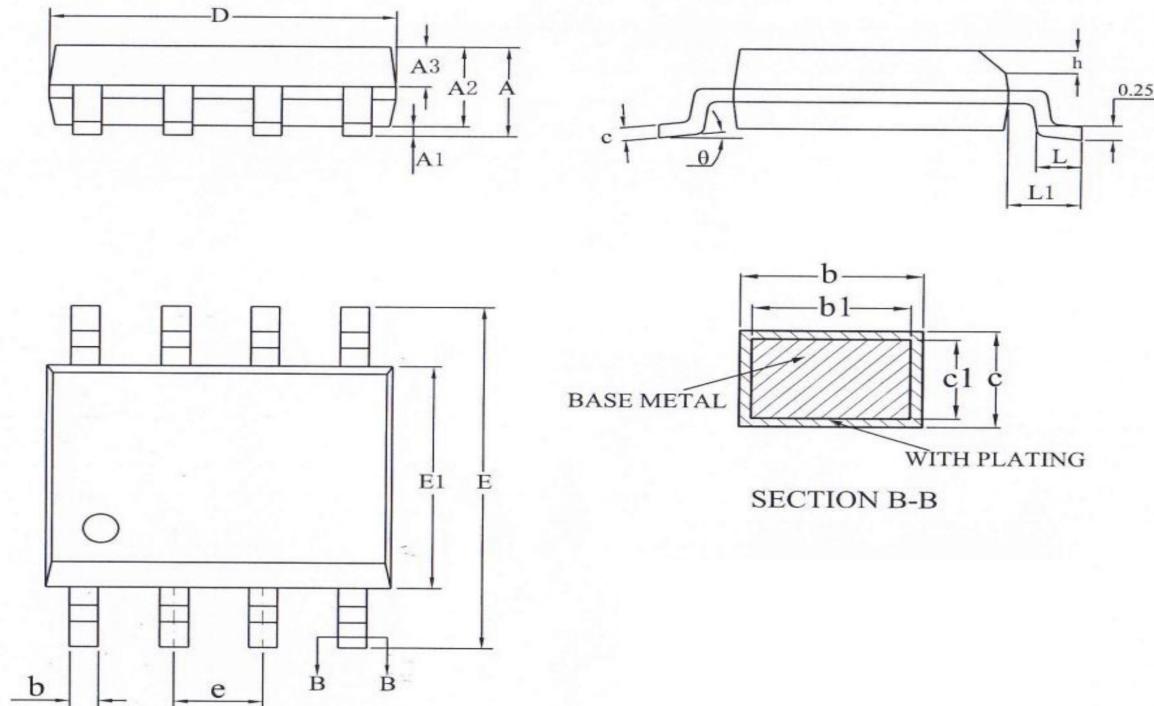


图 7 共模抑制比与频率关系

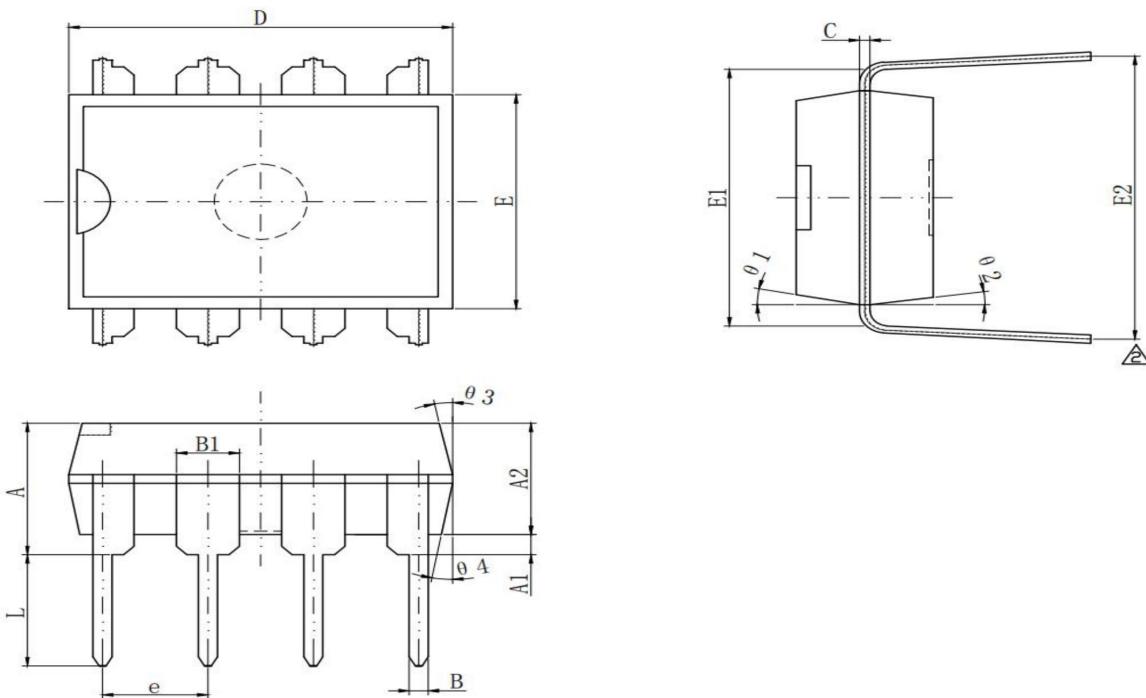
封装机械数据：

SOP8封装



标号	毫米			标号	毫米		
	MIN	NOM	MAX		MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.75	D	4.80	4.90	5.00
A1	0.10	-	0.225	E	5.80	6.00	6.20
A2	1.30	1.40	1.50	E1	3.80	3.90	4.00
A3	0.60	0.65	0.70	e	1.27 BSC		
b	0.39	-	0.47	h	0.25	-	0.50
b1	0.38	0.41	0.44	L	0.50	-	0.80
c	0.20	-	0.24	L1	1.05REF		
c1	0.19	0.20	0.21	theta	0°	-	8°

DIP8封装



标号	毫米			标号	毫米		
	MIN	NOM	MAX		MIN	NOM	MAX
A	3.75	3.90	4.15	E1	7.35	7.62	7.85
A1	0.60	-	-	E2	8.00	8.40	8.80
A2	3.15	3.30	3.40	e	2.54 (BSC)		
B	0.38	0.46	0.56	L	3.00	3.30	3.60
B1	1.52 (BSC)			θ1	10°	-	14°
C	0.20	0.25	0.34	θ2	8°	-	12°
D	9.00	9.25	9.40	θ3	10°	-	14°
E	6.20	6.35	6.50	θ4	8°	-	12°